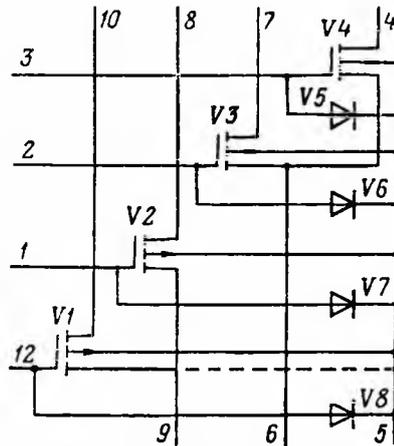


## 190КТ2, К190КТ2

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуцированным каналом *p*-типа. Предназначены для коммутации электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом корпусе типа 201.14-1 (серия К190).

Микросхемы используются как четырехканальный коммутатор.



Принципиальные схемы ИМС 190КТ2, К190КТ2

Параметры	Режим измерения	190КТ2
		К190КТ2
$U_{зи\text{ пор}}$ , В	$U_{ип} = 0; I_c = 10 \text{ мкА}, U_{си} = -5 \text{ В}$	-6
$I_{з\text{ ут}}$ , нА	$U_{зи} = -30 \text{ В}; U_{си} = U_{ип} = 0$	$\leq 30$
$I_{с\text{ нач}}$ , нА	$U_{ип} = U_{зи} = 0; U_{си} = -25 \text{ В}$	$\leq 50$
$I_{п}$ , нА	$U_{ип} = 25 \text{ В}$	$\leq 400$
$R_{отк}$ , Ом	$U_{зи} = -20 \text{ В}, U_{ип} = 0; I_c = 1 \text{ мА}$	$\leq 150$
$R_{отк}$ , Ом	$U_{зи} = -10 \text{ В}; U_{ип} = 0; I_c = 1 \text{ мА}$	$\leq 50$
$C_{11и}$ , пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	$\leq 120$
$C_{12и}$ , пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	$\leq 24$
$C_{22и}$ , пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	$\leq 9$
		15

<sup>1</sup> При температуре  $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации указаны в следующей таблице.

$U_{си}$ , В	$U_{зи}$ , В	$U_{зс}$ , В	$U_{ип}$ , В	$U_{зп}$ , В	$I_c$ , мА	$P_{рас\text{ макс}}$ , мВт
-25	-30	-30	25	-30	$10^1$	200

<sup>1</sup> Для микросхемы 190КТ1, для ИМС 190КТ2  $I_{с\text{ макс}} = 50 \text{ мА}$ .